

原著論文

水熱条件下での $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ の相転移による $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ の作製

大平重男^{1,*}, 宮戸統悦²

¹日本軽金属株式会社, 421-3291 静岡市清水区蒲原 1-34-1

²東北大学金属材料研究所, 980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1

Synthesis of $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ by Phase Transition from $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ under Hydrothermal Conditions

Shigeo OHIRA^{1,*}, Toetsu SHISHIDO²

¹NIKKEI Research and Development Center, Nippon Light Metal Co. Ltd., 1-34-1 Kambara, Shimizu-ku, Shizuoka 421-3291

²Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577

Received August 29, 2007; E-mail: shigeo-ohira@nikkeikin.co.jp

The single phase of $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ was synthesized for the first time by phase transition from $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ single crystals at 400 °C with a pressure of around 1000 atm under hydrothermal conditions. $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ single crystal prepared by floating zone method and the feed material of sintered $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ poly crystal were placed at the upper part and the bottom part of the autoclave for 30 days, respectively. The obtained products after hydrothermal method was characterized by means of X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy, and cathode luminescence. It was found that there was no phase change when H_2O only was used as solvent, but the $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ single crystal was transformed to γ -phase with no residual β -phase when an aqueous solution of LiOH + KOH was used as a solvent.

Key Words: $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$, $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$, Hydrothermal Method, LiOH, Phase Transition

1. はじめに

酸化ガリウム(Ga_2O_3)は酸化アルミニウム(Al_2O_3)と同様、結晶多形が存在し、結晶構造の異なる α , β , γ , δ , ε の5つが知られている[1]。このうち $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ が最も安定で、 $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 以外は低温で準安定な物質である。 $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$ は三方晶系に属し、サファイアと同じコランダム型構造をとる。 $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ は単斜晶系に属し、結晶構造は β -ガリア型構造と呼ばれている。 $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ は $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ と同様のスピネル型構造を有する。 α 相は600 °C以上の加熱で安定な β 相に、また γ 相については400 °C以上で β 相に転移すると報告されている[1,2]。安定な $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ に対しては、酸素センサー[3]、電界効果型トランジスター(FET)[4]、深紫外受光素子[5]、透明導電膜[6]、GaN系FETのゲート材料[7]、さらにGaN薄膜成長用基板[8,9]など各種の応用が検討されている。また、 $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$ に対しても蛍光体への応用などの研究が行なわれている[10]。これに対し、 $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ に関する研究は少なく、 $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$ や $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ に比べると応用例もそれほど多くはない。ガスセンサー[11]や触媒[12]、最近ではMn添加による強磁性体膜への応用[13]や量子ドットの作製により青色-緑色発光を肉眼で観察した結果が報告されている[14]。 $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ の製造法として従来から知られているのは、ゲルを400-500 °Cで加熱する方法[1]、あるいはアモルファス Ga(OH)_3 を100 °C以上で加熱する方法である[2]。また、硝酸ガリウムおよびその水和物を200 °Cで加熱して作製したアモルファス Ga_2O_3 を更に400および600 °Cで加熱する方法[11]、硝酸ガリウムから得られたガリアゲルを500 °Cで加熱する方法[15]、 GaCl_3 の加溶媒分解によって210-240 °C、8-12 hと比較的簡便に $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ が得られる方法が

報告されている[14]。しかしながら、 Ga_2O_3 結晶多形のなかで最も安定な $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ を出発原料として $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$ を作製した例は、筆者らの知る限り今まで報告されたことはない。

前報で我々は、水熱法に用いた溶媒のLiOHと $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ の反応により LiGaO_2 単結晶が成長することを報告した[16]。 LiGaO_2 単結晶は白金製容器の最上部の裏蓋に付着成長したもので、結晶育成域に懸垂した種結晶 $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 単結晶上への結晶成長は認められなかった。また、最初に透明であった $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 単結晶は水熱実験後、白色に変色していることを示したが、前報ではその詳細を報告しなかった。

そこで、本研究では出発原料として用いた $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 単結晶および $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 焼結体の水熱実験後の変化を調べることを目的に、結晶構造や形状観察などの評価を行ったのでその結果について報告する。

2. 実験方法

水熱実験は、前報[16]と同様、耐圧のオートクレーブ中に挿入した内径21 mm ϕ 、長さ165 mmの白金製容器内で行なった。白金製容器内部は、下部が $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 原料(焼結体)を配置した原料・養分溶解域、上部が $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 種結晶(単結晶)を配置した結晶育成域となり、この間を仕切る形に白金製のバッフル板を設置した。原料の $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 焼結体は、1500 °C、10 h、大気中で焼結することで調製した。これを白金製容器底部の原料溶解域にセットした。また、 $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 単結晶はFloating Zone(FZ)法で成長させたものを用い[9]、白金製容器上部の結晶育成域に白金線で吊るした。溶媒の違いによる効果を調べるために、以下の3種類を用いた。すなわち、

1) LiOH(3 mol·l⁻¹)と KOH(1.5 mol·l⁻¹)の水溶液の混合体、2) LiOH(1 mol·l⁻¹)水溶液、および3)純水である。1)～3)から選択した溶媒 50 ml を白金製容器に注入した後、容器を密閉し、オートクレーブに装填して加熱し、圧力を 1000 気圧にした。白金製容器の上部と下部を独立して加熱できるヒータを用いて、下部の温度が 400 °C、結晶育成域に相当する上部の温度が 390 °C になるように約 10 °C の温度差をつけてそれぞれ調整し、結果として超臨界状態で 30 日間保持した。水熱条件下で保持後の β -Ga₂O₃ 単結晶および β -Ga₂O₃ 焼結体について、粉末X線回折(XRD, X線源は CuK α)による結晶構造の決定、走査型電子顕微鏡(SEM, Hitachi 製 S4500)による形状観察を行った。さらに、電子線励起(加速電圧 15 kV)によるカソードルミネッセンス(CL: Shimadzu 製 CL-900)発光を室温で測定した。

3. 結果と考察

Fig.1 は水熱実験前後の結晶育成域にセットした β -Ga₂O₃ 単結晶の変化の様子を示す。Fig.1(a)は水熱実験前の FZ 法で作製した β -Ga₂O₃ 単結晶、Fig.1(b)は溶媒に LiOH(3 mol·l⁻¹)と KOH(1.5 mol·l⁻¹)の混合水溶液を用いた実験後の結果である。FZ 法で育成した β -Ga₂O₃ 単結晶は Fig.1(a)に示すように透明であったが、水熱実験後の結晶は透明性を失って白く変色し、手で押しつけただけで容易に粉碎された。

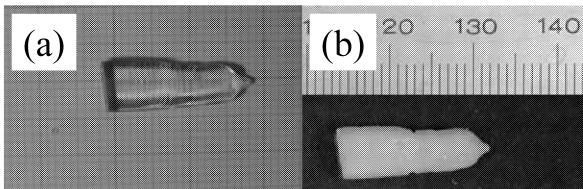


Fig.1 Photograph of β -Ga₂O₃ single crystals before and after hydrothermal method. (a) As grown β -Ga₂O₃ single crystals placed in the growth zone of upper part of autoclave and (b) after hydrothermal method using the aqueous solution of LiOH and KOH.

Fig.2 は、水熱実験後の粉末X線回折による結果を示す。分析に当たっては、乳鉢で粉碎してサンプルとした。Fig.2(a)は溶媒に LiOH と KOH の混合水溶液を用いたとき、結晶育成域に設置した β -Ga₂O₃ 単結晶(Fig.1(b))について水熱実験後に XRD 分析したときの結果であるが、回折パターンを解析した結果、 γ -Ga₂O₃ と一致した。出発原料として用いた β -Ga₂O₃ は検出されていないことから、作製されたのは γ -Ga₂O₃ 単相であるとみられる。また、この回折ピークはシャープであることから、得られた γ -Ga₂O₃ の結晶性も優れていると考えられる。一方、原料溶解域に設置した β -Ga₂O₃ 焼結体からは Fig.2(b) に示すように、 γ -Ga₂O₃、LiGaO₂、LiGa₅O₈ が検出され、残留 β 相は検出されていない。この場合も安定な β 相から γ 相が得られているが、 γ 相単相ではない。溶媒に LiOH 水溶液を用いた場合、Fig.2(c), (d) に示すように、種結晶として結晶育成域に設置した β -Ga₂O₃ 単結晶および原料溶解域に用いた β -Ga₂O₃ 焼結体からはいずれも γ -Ga₂O₃ が検出された。しかしながら、この場合は初期の β -Ga₂O₃ も検出され、全体としては γ -Ga₂O₃ に完全に転移していない。また、Fig.2(c) では β -Ga₂O₃ が主成分となり、LiOH と KOH の混合水溶液を溶媒として用いたときのように、 γ -Ga₂O₃ 単相ではない。さらに、溶媒としてアルカリ水溶液を用いずに、純水を用いた場合には、XRD による変化は認められなかった。水熱条件下

において LiOH、KOH などのアルカリ水溶液を溶媒として用いることで、安定な β -Ga₂O₃ から準安定な γ -Ga₂O₃ を作製できることが示された。溶媒が LiOH 水溶液の場合、初期の β 相が残留するが、LiOH と KOH の混合水溶液が溶媒の場合には、 β 相は γ 相に完全に転移する。特に、結晶育成域に設置した β -Ga₂O₃ 単結晶は、 γ -Ga₂O₃ 単相に相転移することが明らかになった。

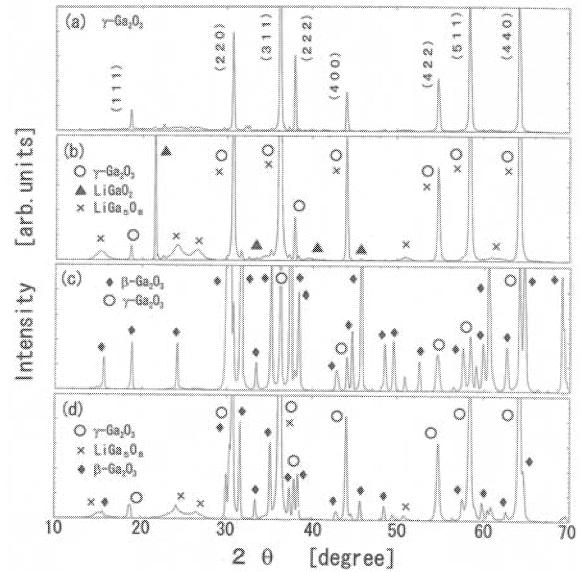


Fig.2 XRD 2θ/θ spectra of the products after hydrothermal method. Precursor and used solution are as follows, respectively. (a) β -Ga₂O₃ single crystal using LiOH + KOH solution, (b) sintered β -Ga₂O₃ using LiOH + KOH solution, (c) β -Ga₂O₃ single crystal using LiOH solution and (d) sintered β -Ga₂O₃ using LiOH solution.

今回の結果は、水熱条件下で結晶育成域にセットした β -Ga₂O₃ 単結晶は γ -Ga₂O₃ に、また原料溶解域に用いた β -Ga₂O₃ 焼結体は γ -Ga₂O₃、LiGaO₂、LiGa₅O₈ に相転移ないし化学変化したことを示す。これは、高温高圧下の水熱条件下において β -Ga₂O₃ から γ -Ga₂O₃ へ相転移が生じていることを示唆する結果で、安定な β -Ga₂O₃ を出発原料として準安定な γ -Ga₂O₃ を作製するという従来の報告とは逆の方法による γ -Ga₂O₃ の新しい製造方法になる。この場合、結晶構造は β 相の单斜晶から γ 相の立方晶に変化したことになる。Roy らの報告によると、存在する Ga₂O₃ の結晶多形体は、最終的に最も安定な β -Ga₂O₃ に転移する。 γ 相は 400 °C で β 相に転移することが示されているが、この場合は常圧においてであり、今回のような 1000 気圧の高圧下においては、ほぼ同じ温度でその逆も起こり得ることを示唆する。安定な相から準安定な相へ転移した駆動力としては、超臨界状態の雰囲気の他、アルカリ添加剤の影響などが考えられる。

今回の実験では、溶媒に純水を用いた場合には変化は見られず、相転移はアルカリ水溶液を溶媒として用いたときのみ生じた。この結果は、1000 気圧、400 °C の水熱条件だけでは、 β 相から γ 相への相転移は起こらず、アルカリ添加剤の存在が関与していることが示唆される。このとき、アルカリ添加剤の種類として LiOH のみだと β -Ga₂O₃ 単結晶は β 相と γ 相が共存する状態に移行するという結果が得られたが、LiOH-KOH の複合系にすると、 γ -Ga₂O₃ 単相が得られた。この結果は、

LiOH が相転移に最も深く関与している可能性があることを唆す。KOH の役割については、前報[16]の結果から γ -Ga₂O₃ 単相の形成を早める作用をもたらすと考えられるが、KOH 単独溶媒でのデータがないため、詳細は不明である。しかしながら、前報で報告した LiGaO₂ 単結晶の水熱成長の際、溶媒に用いた LiOH のみが化学反応に関与し、LiOH と複合して用いた KOH は β -Ga₂O₃ の溶解を高めることには寄与したが、 β -Ga₂O₃ と反応して化合物を形成することはなかった。このことから、今回の β 相から γ 相への相転移においても、LiOH が支配的に関与し、KOH は相転移を助長する役割を担っているものと考えられる。

高温高圧下で Ga 酸化物系化合物が相転移することは、すでにベル研のグループから報告されている[17-19]。Remeika らは、 β 相から α 相の Ga₂O₃ を得ている。この場合、フランクスに NaOH を用い、 β -Ga₂O₃ 粉末をモル比で 2:5 として、1000 °C, 44 kbars の圧力で 1 h 保持した結果、 α -Ga₂O₃ 単結晶が成長することを報告している[18]。また、30 kbars, 850 °C の条件で β -LiGaO₂ から α -LiGaO₂ への転移も報告されている[17]。しかしながら、この場合の圧力は我々が用いた 1000 気圧に対し約 30~44 倍と非常に高く、温度も 400 °C に対し 850~1000 °C と 2 倍以上高い。さらに、 β -Ga₂O₃ から γ -Ga₂O₃ への転移の報告はなく、筆者らの知る限り、 β -Ga₂O₃ から γ -Ga₂O₃ を作製したのは今回の我々の結果が最初であると思われる。本法では 1000 気圧の高圧を用いるが、390~400 °C と比較的の低温で、アルカリ水溶液溶媒を介在させて、安定な β -Ga₂O₃ を出発原料として、準安定な γ -Ga₂O₃ を合成できる。また純水に添加するアルカリの種類を選択指定することで γ -Ga₂O₃ 単相化が達成できる。本法で得られる γ -Ga₂O₃ は、従来報告されている製法[15]で得られたものと比べて、XRD の回折ピークの半値幅が小さく、結晶性の面においても優れている。

Fig.3 は結晶育成域から得られた γ -Ga₂O₃ (Fig.2 (b)), および原料溶解域から得られた γ -Ga₂O₃, LiGaO₂, LiGa₅O₈ についての SEM 観察を示す。Fig.3(a) の β -Ga₂O₃ 単結晶から作製された γ -Ga₂O₃ の形状は、Fig.3(b) と比べても不規則で、サイズは数 μm の棒状のものから数 10 μm の塊状のものまで多岐に分布しているのがわかる。これに対し、 β -Ga₂O₃ 焼結体から得られた γ -Ga₂O₃, LiGaO₂, LiGa₅O₈ の混合相は、板状に重なり、一定の規則性ある構造であった。両者とも、構造はポーラス状に見える。これは、原料の単結晶、および多結晶表面から溶解と析出が起こり、この現象が内側へ浸透しつつ起きたため結果として構造がポーラスになったと考えられる。

Fig.3(a), (b) のサンプルに対応した CL 測定結果を Fig.4 に示す。 β -Ga₂O₃ と γ -Ga₂O₃ を比べると、CL 発光波長の位置、およびスペクトル形状が異なっているのがわかる。Fig.4(b) の β -Ga₂O₃ は約 400 nm 付近で発光しているのに対し、(a) の γ -Ga₂O₃ のスペクトル形状はブロードで半値幅も広く、発光位置は長波長側にシフトしている。注目されるのは、波長がおよそ 410 と 460 nm の 2 箇所で比較的シャープに発光していることである。 γ -Ga₂O₃ に対して同様な 2 つの発光ピークは、文献[14]でも報告されており、この場合は γ -Ga₂O₃ の粒径が 4.2 nm と小さいことに起因する量子効果で説明されるが、今回の実験で我々が得た γ -Ga₂O₃ は、Fig.3(a) の SEM 写真で示すように、粒径は μm レベルであるため、サイズ効果が期待できるほどの粒径ではない。従って、CL 発光のピーク位置のシフトは不純物混入による影響が考えられる。今回得られた γ -Ga₂O₃ には XRD では検出できなかったが、溶媒成分中の Li や K が混入した可能性もあり、これが不純物準位を形成し、CL 発光特性に影響したと思われる。

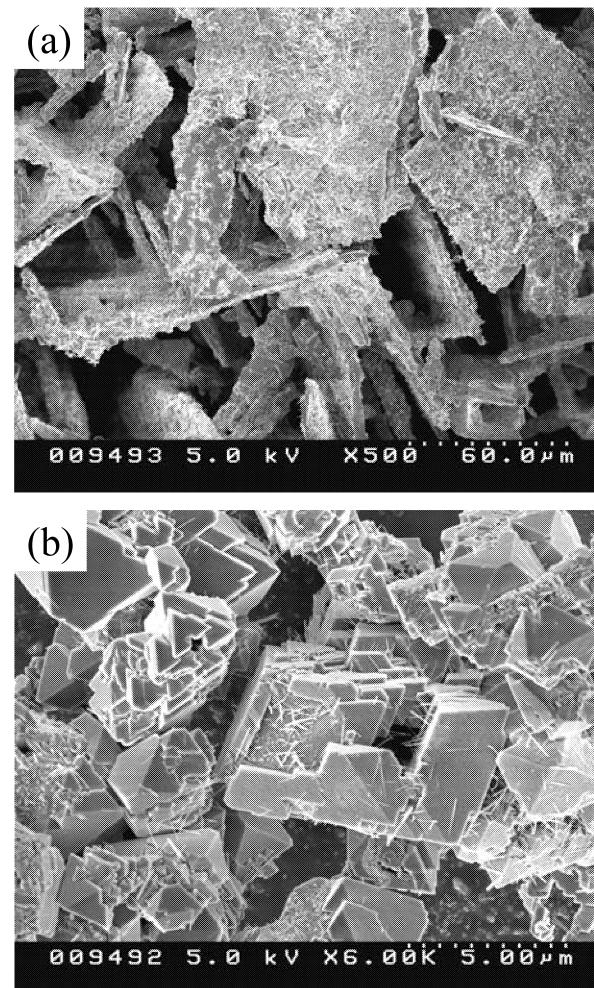


Fig.3 SEM images of the products after hydrothermal method in the aqueous solution of LiOH and KOH. The crystal phases of the products were determined by XRD. (a) γ -Ga₂O₃ and (b) γ -Ga₂O₃ + LiGaO₂ + LiGa₅O₈.

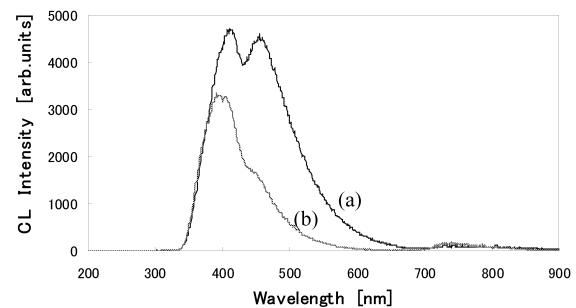


Fig.4 CL emission spectra from (a) γ -Ga₂O₃ obtained from hydrothermal method and (b) β -Ga₂O₃ powder.

4. まとめ

1000 気圧、390~400 °C, LiOH と KOH の混合水溶液を溶媒として用いた水熱条件下で 30 日間保持した結果、結晶育成域に設置した β -Ga₂O₃ 単結晶の結晶成長は認められず、 β -Ga₂O₃ 単結晶は γ -Ga₂O₃ 単相に相転移した。また、原料溶解域

に設置した β -Ga₂O₃ 焼結体は γ -Ga₂O₃, LiGaO₂, LiGa₅O₈ の混合相に変化し、この場合も初期の β -相は完全に消滅した。溶媒に純水を用いた場合には何ら変化は見られず、また溶媒に LiOH 水溶液を用いた場合では、 γ -相が得られましたが、初期の β -相が残留し、 γ -Ga₂O₃ 単相は得られなかつた。LiOH と KOH の混合溶媒を用いることで、 β -Ga₂O₃ から γ -Ga₂O₃ 単相が得られるなどを初めて明らかにした。

今回の実験で得られた相転移のメカニズムについては、今後 KOH 単独溶媒を用いた実験結果を参考しながら、考察していく予定である。

謝辞

水熱実験に当たっては東北大金属材料研究所の小原和夫技術補佐員のご協力を得た。サンプルの分析は日本軽金属株式会社グループ技術センターの分析グループにより実施された。記して感謝の意を表します。

References

- 1) R. Roy V. G. Hill, E. F. Osborn, *J. Am. Chem. Soc.*, **1952**, 74, 719.
- 2) T. Sato, T. Nakamura, *Thermochimica Acta*, **1982**, 53, 281.
- 3) M. Fleischer, W. Hanreider, H. Mexner, *Thin Solid Film*, **1990**, 190, 93.
- 4) K. Matsuzaki, H. Yanagi, T. Kamiyama, H. Hiramatsu, K. Nomura, M. Hirano, H. Hosono, *Appl. Phys. Lett.*, **2006**, 88, 092106.
- 5) P. Feng, J. Y. Zhang, Q. H. Li, T. H. Wang, *Appl. Phys. Lett.*, **2006**, 88, 153107.
- 6) M. Orita, H. Hiramatsu, H. Ohta, M. Hirano, H. Hosono, *Thin Solid Film*, **2002**, 411, 134.
- 7) S. A. Lee, J. Y. Hwang, J. P. Kim, S. Y. Jeong, C. R. Cho, *Appl. Phys. Lett.*, **2006**, 89, 182906.
- 8) K. Shimamura, E. G. Villora, K. Domen, K. Yui, K. Aoki, N. Ichinose, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **2005**, 44, L7.
- 9) S. Ohira, M. Yoshioka, T. Sugawara, K. Nakajima, T. Shishido, *Thin Solid Film*, **2006**, 496, 53.
- 10) S. Cho, J. Lee, I. Y. Park, S. Kim, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **2002**, 41, 5253.
- 11) D. Kisailus, J. H. Choi, J. C. Weaver, W. Yang, D. E. Morse, *Adv. Mater.*, **2005**, 17, 314.
- 12) M. Rodriguez Delgado, C. Morterra, G. Cerrato, G. Magnacca, C. Otero Arean, *Lagmuir*, **2002**, 18, 10255.
- 13) H. Hayashi, R. Huang, H. Ikeno, F. Oba, S. Yoshioka, I. Tanaka, S. Sonoda, *Appl. Phys. Lett.*, **2006**, 89, 181903.
- 14) T. Chen, K. Tang, *Appl. Phys. Lett.*, **2007**, 90, 053104.
- 15) C. Otero Arean, A. Lopez Bellan, M. Penarroya Mentrut, M. Rodriguez Delgado, G. Turnes Palomino, *Microporous Mesoporous Mater.*, **2000**, 40, 35.
- 16) S. Ohira, T. Shishido, *J. Flux Growth*, **2007**, 1, 88. [in Japanese].
- 17) M. Marezio, J. P. Remeika, *J. Phys. Chem. Solids.*, **1965**, 26, 1277.
- 18) J. P. Remeika, A. A. Ballman, *Appl. Phys. Lett.*, **1966**, 8, 87.
- 19) M. Marezio, J. P. Remeika, *J. Chem. Phys.*, **1967**, 46, 1862.